








	<h2>SI7686DP-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7686DP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7686DP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 178756 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7686DP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	178756 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 35A (Tc) 5W (Ta), 37.9W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 37.9W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 13.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1220pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7686DP-T1-E3TR





SI7686DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7686DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7686DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7686DP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7686DP-T1 VISHAY SI7686DP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7703DN VISHAY SI7703DN VISHAY</p>	 <p>SI7686DP P/b VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SI7686 SI SI7686 SI</p>
 <p>SI7686DP VISHAY SI7686DP VISHAY</p>	 <p>SI7686DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7703EDN-T1 VISHAY SI7703EDN-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7686DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

 SI7658ADP-T1-GE3	 SI7658DP-T1-GE3	 SI7660CJ	 SI7660DY	 SI7660DY-T1
 SI7660DY-T1-E3	 SI7661CJ	 SI7661CSA	 SI7661CSA+	 SI7668ADP-T1-E3
 SI7668ADP-T1-E3	 SI7668ADP-T1-GE3	 SI7668ADP-T1-GE3	 SI7674DP	 SI7674DP-T1-GE3
 SI7674DP-T1-GE3	 SI7682DP	 SI7682DP-T1-E3	 SI7682DP-T1-E3	 SI7682DP-T1-GE3
 SI7682DP-T1-GE3	 SI7682DY-T1-GE3	 SI7684DP-T1-GE3	 SI7686DP	 SI7686DP-T1
 SI7686DP-T1-E3	 SI7686DP-T1-GE3	 SI7686DP-T1-GE3	 SI7703DN	 SI7703EDN
 SI7703EDN-T1	 SI7703EDN-T1-E3	 SI7703EDN-T1-E3	 SI7703EDN-T1-GE3	 SI7703EDN-T1-GE3
 SI7703EDN-T1-E3	 SI7705DN	 SI7705DN-T1	 SI7705DN-T1-E3	 SI7716ADN
 SI7716ADN-T1-E3	 SI7716ADN-T1-GE3	 SI7716ADN-T1-GE3	 SI7716ADN-T1-GE3	 SI7716DN-T1-GE3
 SI7720DN-T1-E3	 SI7720DN-T1-GE3	 SI7720DN-T1-GE3	 SI7726DN	 SI7726DN-T1-E3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited